

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年12月10日(10.12.2020)



(10) 国際公開番号

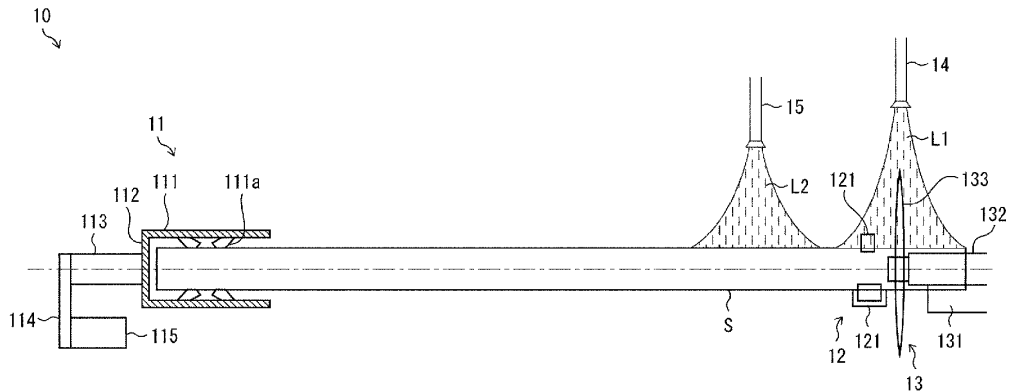
WO 2020/246152 A1

- (51) 国際特許分類:
B28D 7/02 (2006.01) B24B 55/06 (2006.01)
B24B 27/06 (2006.01) B28D 5/02 (2006.01)
B24B 55/02 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2020/016832
- (22) 国際出願日: 2020年4月17日(17.04.2020)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2019-106232 2019年6月6日(06.06.2019) JP
- (71) 出願人: 株式会社 トクヤマ (TOKUYAMA CORPORATION) [JP/JP]; 〒7458648 山口県周南市御影町1番1号 Yamaguchi (JP).
- (72) 発明者: 阪井 純也 (SAKAI, Junya); 〒7458648 山口県周南市御影町1番1号 株式会社 トクヤマ内 Yamaguchi (JP). 田崎 博之 (TASAKI, Hiroyuki); 〒7458648 山口県周南市御影町1番1号 株式会社 トクヤマ内 Yamaguchi (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人 H A R A K E N Z O W O R L D P A T E N T & T R A D E M A R K (HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK); 〒5300041 大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2番6号 大和南森町ビル Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,

(54) Title: METHOD FOR CUTTING POLYCRYSTALLINE SILICON ROD, METHOD FOR MANUFACTURING CUT ROD OF POLYCRYSTALLINE SILICON ROD, METHOD FOR MANUFACTURING NUGGET OF POLYCRYSTALLINE SILICON ROD, AND POLYCRYSTALLINE SILICON ROD CUTTING DEVICE

(54) 発明の名称: 多結晶シリコンロッドの切断方法、多結晶シリコンロッドのカットロッドの製造方法、多結晶シリコンロッドのナゲットの製造方法、および多結晶シリコンロッドの切断装置

【図1】



(57) Abstract: The present invention realizes a method which prevents metal contamination when cutting a polycrystalline silicon rod. The present invention pertains to a method, for cutting a polycrystalline silicon rod (S), that includes a cutting step for cutting the polycrystalline silicon rod (S) via a cutting tool (133), wherein, during the cutting step, a liquid (L1) is supplied from a first nozzle (14) to a cutting position of the polycrystalline silicon rod (S), and a liquid (L2) is supplied from a second nozzle (15) to a surface of the polycrystalline silicon rod (S).

【続葉有】

WO 2020/246152 A1

DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 多結晶シリコンロッドの切断時に、金属汚染を防ぐ方法を実現する。多結晶シリコンロッド (S) を切断工具 (133) によって切断する切断工程を含む多結晶シリコンロッド (S) の切断方法であって、切断工程では、第1のノズル (14) から多結晶シリコンロッド (S) の切断位置に液体 (L1) を供給し、第2のノズル (15) から多結晶シリコンロッド (S) の表面に液体 (L2) を供給する。